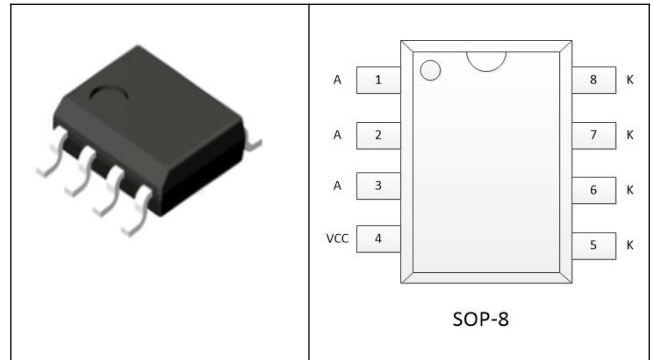


。内了功，可以
大低二，，取代
前场上基二。

- B 充 器
- 器
- 动

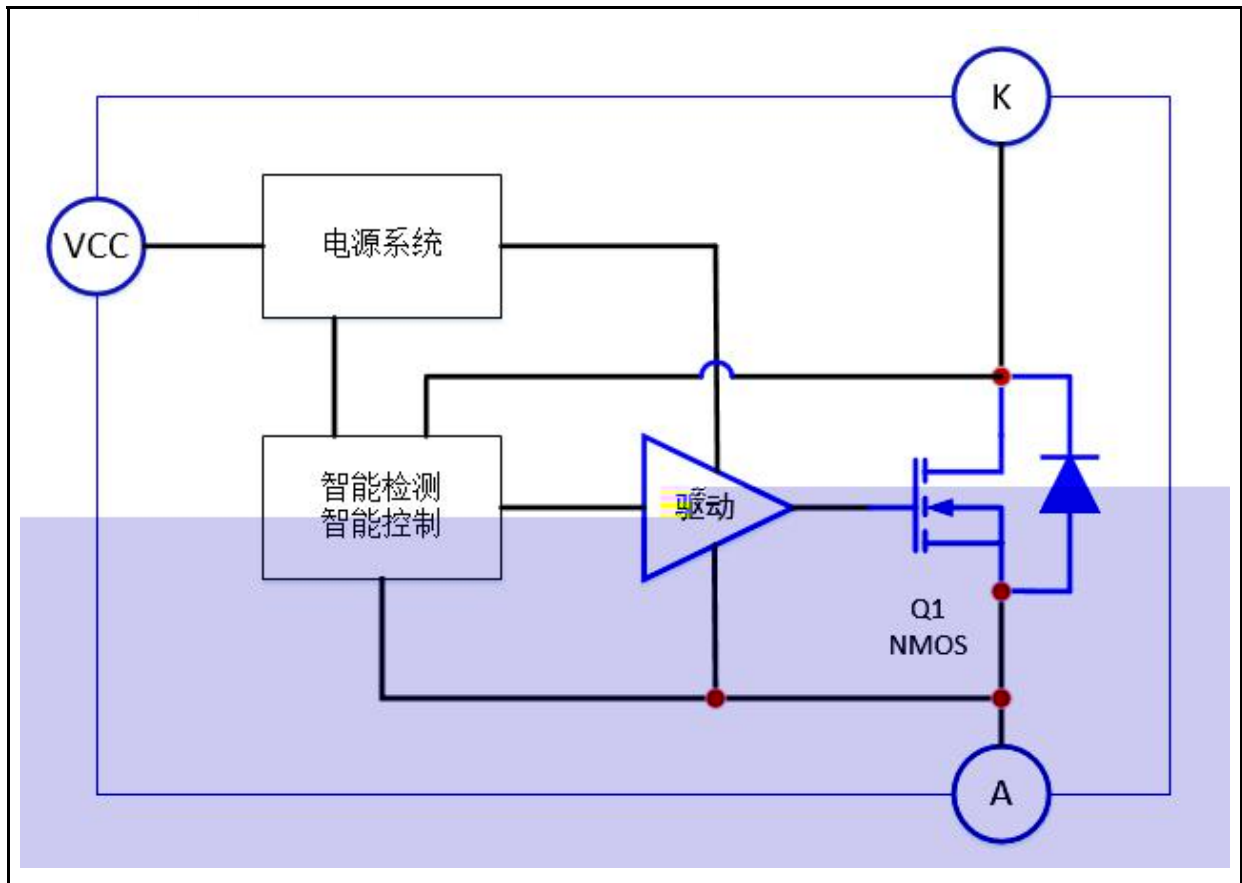
- 于反
- 低
- 低 升
- 功
- 可 作于 C、
- ， 前 同 信号
- C 善
- 可以 基二
- 任何外围



号	名	
	A	同二
	CC	供。
		同二

产品型号	入 压	典型功
DK V R P	VAC	V A

A



参	号	值	典型值	大值	单 位
压	B				
大	C C				A
大 值	C				A
功	A				
(到 境)	A				°C
(到 壳)	C				°C
储存 围					°C
作 围					°C
					°C

备 注 : (A °C) 件下

， 任何外围器件，可以大 低传 基二 ， 在 低 CC 出

外 。在 低 ， 出 压低于启动 压 ， 内 功
关 ， 依 体二 。 压大于 ， 启动 。 压 低到复位
压 以下 ， 入启动 。

NMOS

到 A、 向 压大于 压 ， 则 功 ； 到
功 减 到 ， 即 A、 向 压为 ， 则关 功 。

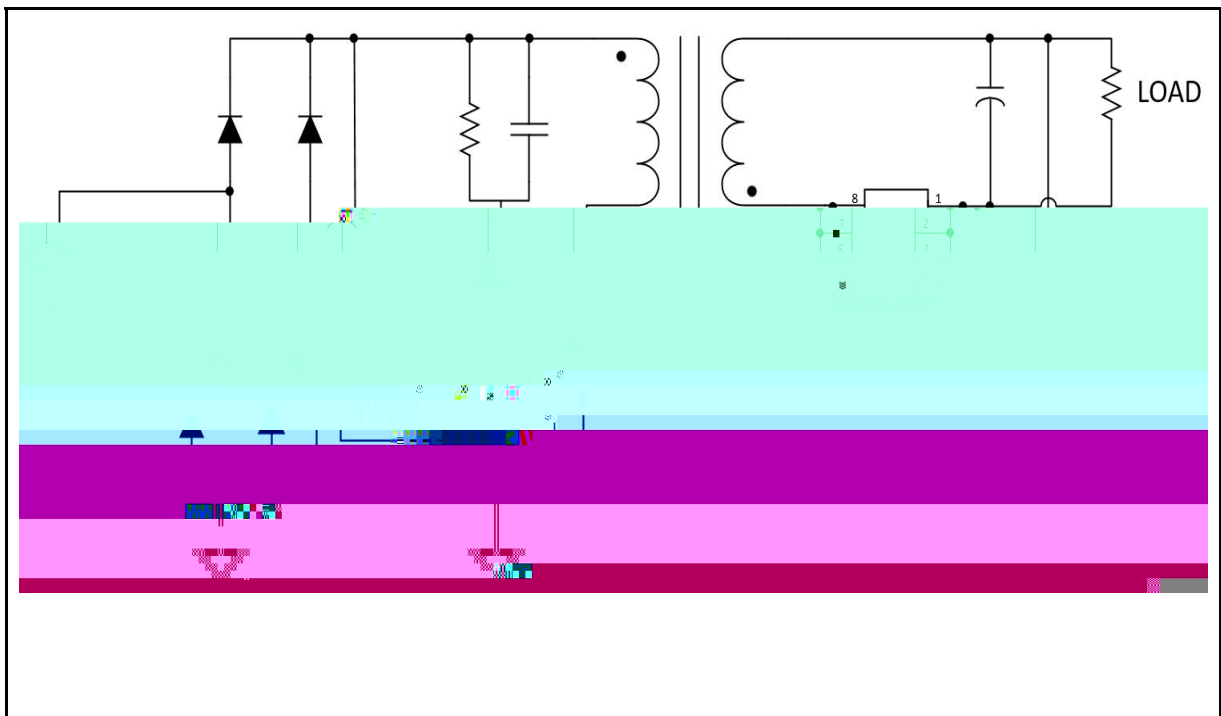
RC

在启动、 出 、 入 压 CC 在二 体产 压,为 内
压击 ， 可以在 A 和 之 入 C 吸 ， 以减 压。

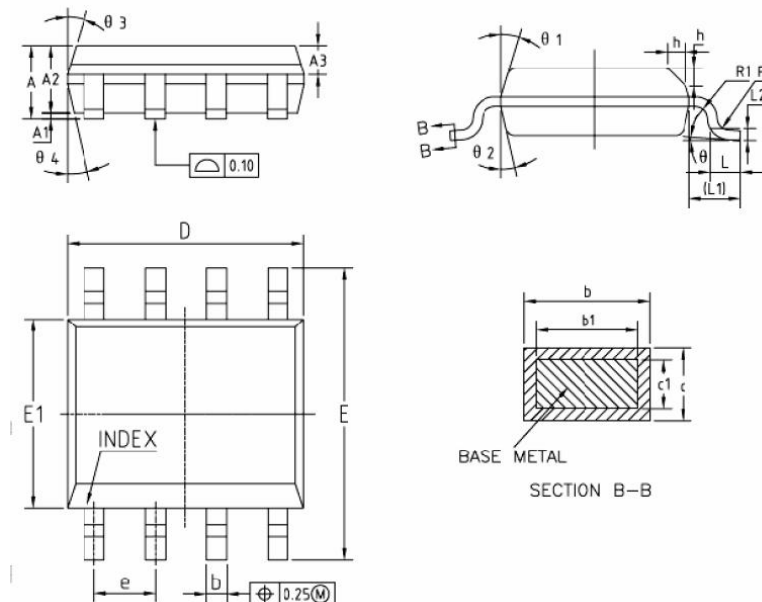
NMOS

于 存在 。在 作 中， 升 ， 内 值会增大， 会 低。
可 增加 ， 低 C 作 。

L Side

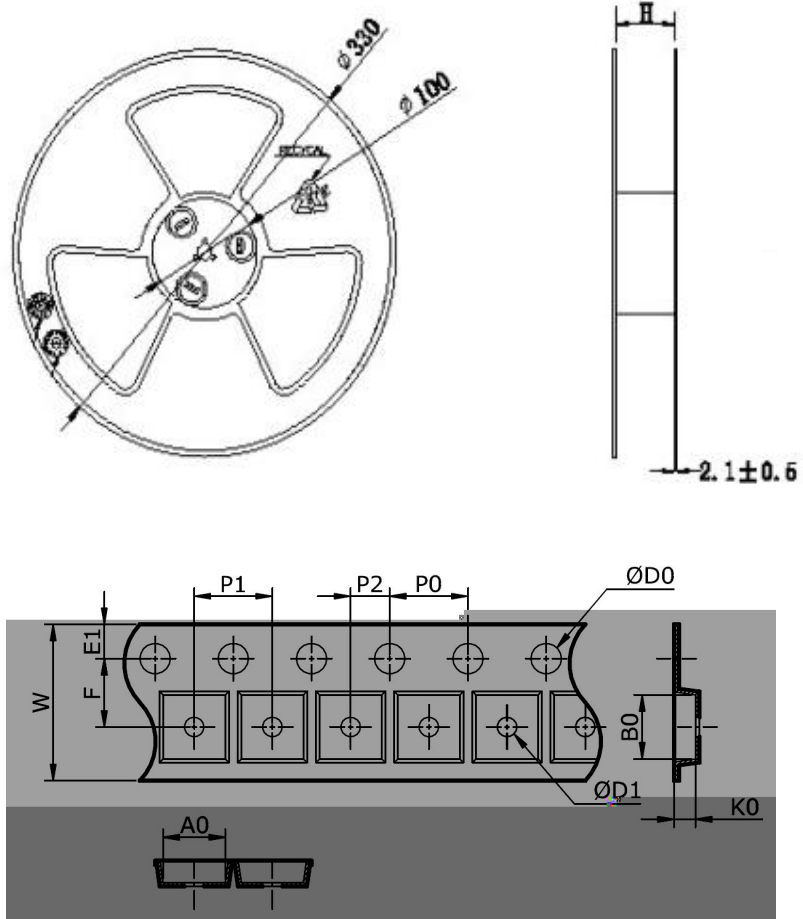


SOP



Symbol	Dimension In Millime e	
	Min	Ma
A		
A		
A		
A		
		B C
		B C
θ		

K




SOP Package

A

B

() () () () ()

?? ?

 <p>WARNING! ESD SENSITIVE DEVICE</p>	<p>： 产品为 元件， ! ESD 围可以 从 下 大到 备 。 可 受到 ， 因 可 元件参 不 公 。</p>
---	--

- 使 公司 产品， 在使 前仔 。
- 安 东 半 体 公司保 利， 不另 。
- 安 东 半 体 公司 任何 其产品 于 为不 任何 任。
- 安 东 半 体 公司 为 于 产品 供使 和 义务。
- 安 东 半 体 公司不会 其专利 可以及任何其他 关 可 利。
- 任何半 体产品 件下 一 失 发 可 ， 买 任在使 安 东 半 体 公司
产品 和 制 守安全 准 取安全 ， 以 免 在失 可 人 伤 产
失 况 发 ！
- 产品 升 境， 公司 为 供 优 产品